Der NF-Transistor GC 101 (alte Bezeichnung OC 870 rauscharm) ist ein legierter Ge-pnp-Flächentransistor in der Bauform A 1 nach TGL 11811 (entspricht ≈ TO-18-Gehäuse).

Der Transistor ist für den NF-Bereich bestimmt, wobei dieses Bauelement als Vorstufentransistor mit höheren Anforderungen an die Grenzfrequenz und Rauschfaktor (< 10 dB) ausgelegt ist.

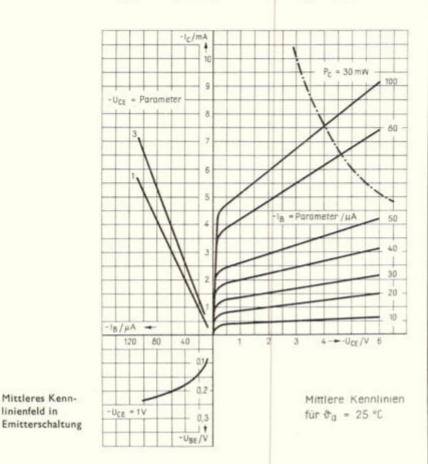
Statische Kennwerte (für $\vartheta a = 25\,^{\circ}C\,$ — 5 grd)

Kollektorrestströme

$$\begin{array}{lll} -I_{CBO} = 1.5 \le 15 \, \mu A & \text{bei } -U_{CB} = 6 \, V \\ -I_{CBO} = 50 \le 500 \, \mu A & \text{bei } -U_{CB} = 25 \, V \\ -I_{CEO} = 55 \le 800 \, \mu A & \text{bei } -U_{CE} = 6 \, V \end{array}$$

Emitterreststrom

$$-I_{EBO} = 50 \le 500 \,\mu\text{A}$$
 bel $-U_{EB} = 15 \,\text{V}$



Rauschmaß

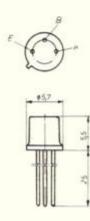
Mittleres Kenn-

linienfeld in



Abmessungen

Bauform A 1 nach TGL 11811



Masse 0,4 g

Vierpolwerte in Emitterschaltung

$$\begin{array}{lll} (bei \; -U_{CE} = 6 \; V & -I_{C} = 2 \; mA) \\ f_m & = 1 \; kHz \\ h_{11e} = 0,6 & (0,2\dots 5 \; k\Omega) \\ h_{12e} = 4 \cdot 10^{-4} & \leq \; 30 \cdot 10^{-4} \\ h_{22e} = 56 & \leq \; 200 \; \mu S \\ h_{21e} = 18\dots 35 \; Stromverstärkungsgruppe \; a \\ & 29\dots 55 \; Stromverstärkungsgruppe \; b \; II \\ & 45\dots 88 \; Stromverstärkungsgruppe \; c \; III \\ & \geq 72 \; Stromverstärkungsgruppe \; d \; IIII \end{array}$$

Wärmewiderstand

$$R_{th} \leq 1 \, \frac{grd}{mW}$$

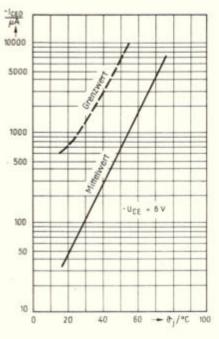
Grenzwerte (für $\vartheta_a = 45$ °C)

$$-U_{CBO} = 15 \text{ V}$$
 $-I_{C} = 15 \text{ mA}$ $I_{E} = 15 \text{ mA}$ $-I_{B} = 5 \text{ mA}$ $\theta_{1} = 75 \,^{\circ}\text{C}$ $\theta_{a} = 65 \,^{\circ}\text{C}$

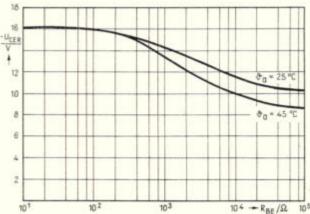
Grenzfrequenz in Basisschaltung

$$\begin{array}{c} f_{h21b}=2,1\geq 1~\text{MHz}\\ \text{bei}~-U_{CE}=6~\text{V}\\ f_{M}~=1~\text{MHz} \end{array} \qquad \begin{array}{c} -I_{C}=0,5~\text{mA}\\ f_{o}=0,1~\text{MHz} \end{array}$$

Bestellbezeichnung für einen Transistor der Stromverstärkungsgruppe c 45...88: Transistor GC 101 c



Kollektorreststrom als Funktion der Sperrschichttemperatur



Kollektoremitterspannung als Funktion des äußeren Basisemitterwiderstandes